

MIL-PRF-55342

具有全蒸鍍環繞端子，確保出色的附著力和尺寸均勻性。它們在需要嚴格性能要求的應用中非常理想。通過 100%篩選和廣泛的環境批次測試，確保了其可靠性。

- 確保了可靠性：具有建立的可靠性，採用“S”和“V”失效率等級（10 ppm），C = 2。
- 高純度氧化鋁基板：使用高純度氧化鋁基板。
- 環繞端子：具有堅韌的附著力層，表面電鍍鎳屏障層，適用於+150°C的操作條件。
- 極低噪聲和電壓系數：噪聲低於-25 dB，電壓系數為 0.5 ppm/V。
- 非感應性：是非感應性的。
- 激光修剪的容差：±0.1%的激光修剪容差。
- 環繞電阻：典型值小於 0.010 Ω。
- 批內跟踪：小於 5 ppm/°C。
- 完整的 MIL 測試：可在內部進行完整的 MIL 測試。
- 防靜電格子包裝或帶卷包裝：提供防靜電格子包裝或帶卷包裝。

軍事/航空航天/QPL：適用於軍事、航空航天和 QPL（質量批准清單）應用。

軍規號碼	功率 mW	電阻範圍 Ω	工作電壓 V
M55342/01	50	20 to 150K	40
M55342/02	125	20 to 301K	40
M55342/03	200	10 to 649K	75
M55342/04	150	10 to 1.69M	125
M55342/05	225	10 to 3.16M	175
M55342/06	150	10 to 475K	50
M55342/07	250	10 to 1.5M	100
M55342/08	800	10 to 4.02M	150
M55342/09	1000	10 to 6.19M	200
M55342/10	500	49.9 to 1M	75
M55342/11	50	20 to 100K	30
M55342/12	100	10 to 258K	50

材料規格與特性

材料：Tamelox 電阻器膜（鍍覆的鎳鉻）。

電阻範圍：10 Ω 到 6.19 MΩ。

溫度系數（TCR）：絕對 ± 25 ppm/°C 到 ± 300 ppm/°C，在 -55 °C 到 +125 °C

條件下。

容差：絕對 $\pm 0.1\%$ 、 $\pm 0.25\%$ 、 $\pm 0.5\%$ 、 $\pm 1\%$ 、 $\pm 2\%$ 、 5% 、 $\pm 10\%$ 在 $+25\text{ }^\circ\text{C}$ 條件下。

穩定性（絕對）： $\Delta R \pm 0.02\%$ 在 $+70\text{ }^\circ\text{C}$ 的 2000 小時內。

電壓系數： 0.1 ppm/V 。

工作電壓： 30 V 到 200 V 。

操作溫度範圍： $-65\text{ }^\circ\text{C}$ 到 $+150\text{ }^\circ\text{C}$ 。

儲存溫度範圍： $-65\text{ }^\circ\text{C}$ 到 $+150\text{ }^\circ\text{C}$ 。

噪聲：小於 -25 dB 。

保存期限穩定性（絕對）： $\Delta R \pm 0.01\%$ 在 $+25\text{ }^\circ\text{C}$ 條件下的 1 年。

電阻元件：Tamelox。

基板材料：氧化鋁（Alumina）。

晶片端子：鍍鎳的錫/鉛焊接。

熔結焊料：錫/鉛焊合金。

型號選擇

範例: D55342E07B100AP

D55342 E 07 B 100A P

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(A) 軍規號碼: M55342 或 D55342(D55342 只有/07 尺寸可選)

(B) 特性: E = $25\text{ ppm}/^\circ\text{C}$

H = $50\text{ ppm}/^\circ\text{C}$

K = $100\text{ ppm}/^\circ\text{C}$

L = $200\text{ ppm}/^\circ\text{C}$

M = $300\text{ ppm}/^\circ\text{C}$

(C) 尺寸: 01 = 0502

02 = 0505

03 = 1005

04 = 1505

05 = 2208

06 = 0705

07 = 1206

08 = 2010

09 = 2512

10 = 1010

11 = 0402

12 = 0603

(D) 終端: B = 可焊錫

(E) 電阻值:

誤差值	1Ω	1kΩ	1MΩ
0.1%	A	B	C
0.25%	R	U	V
0.5%	W	Y	Z
1%	D	E	F
2%	G	H	T
5%	J	K	L
10%	M	N	P

例如: 100A = 100Ω , 1C00 = 1MΩ

(F) 失效率: M = 1.0 % / 1000 h

P = 0.1 % / 1000 h

R = 0.01 % / 1000 h

U = 0.01 % / 1000 h

S = 0.001 % / 1000 h

V = 0.001 % / 1000 h

C = non ER version